

「第3回応用物理学会 業績賞受賞記念講演」

(社) 応用物理学会

応用物理学会第3回業績賞(研究業績)は2003年3月27日に春季学術講演会において飯島澄男氏と田中昭二氏とに贈呈されました。飯島氏の受賞記念講演を下記のように開催いたしますので誘い合わせてご参加ください。なお、田中氏の記念講演は、春季講演会にて開催しました。

記

日時：2003年8月30日(土) 11:00～12:00

会場：福岡大学 七隈キャンパス 10号館 1F-1011 (YA会場)

飯島 澄男 氏 (名城大学 教授、NEC基礎研究所 特別主席研究員、科学技術振興事業団 基礎的研究発展事業飯島チーム代表研究者、独立行政法人産業技術総合研究所 新炭素系材料開発研究センター センター長)

演 題 「ナノチューブの科学・技術」

■ シンポジウム一覧

開催日	時 間	会 場	テ ー マ	世 話 人 (所 属)
8/30 (土)	13:00～17:30	A棟-D (24)	薄膜・表面物理分科会企画 「原子レベル制御ナノテクノロジー：A Pre-Symposium of ACSIN-7」	市川 昌和 (東大 院工)
	13:00～17:10	A棟-F (24)	ナノ光化学と分子スケールエレクトロニクスのレゾナンス	味戸 克裕 (NTT物性基礎研) 石田 敬雄 (産総研)
	13:30～17:40	8-ZD (24)	最先端 SiGe(C)技術とそのデバイス応用	櫻庭 政夫 (東北大通研) 中川 清和 (山梨大工) 酒井 朗 (名大院工) 中島 寛 (九大先端研)
	13:00～17:10	10-YA (24)	応用電子物性分科会60周年記念講演会 「応用電子物性研究、今後の進展・夢」	佐野 雅敏 (東理大) 徳光 永輔 (東工大) 井須 俊郎 (三菱電機) 奥村 元 (産総研)
	14:00～17:40	10-YC (24)	磁場応用新領域グループ企画 「強磁場応用技術の新展開」	山本 勲 (横国大院工) 廣田 憲之 (東大新領域)
8/31 (日)	13:00～17:20	A棟-C (24)	先端固体放射線検出器の開発動向	南戸 秀仁 (金沢工大) 西沢 博志 (三菱電機)
	13:00～17:40	A棟-D (24)	結晶工学分科会企画「太陽電池の結晶工学 一低コスト・高効率・大面積・高信頼性を求めて」	和田 隆博 (龍谷大) 中嶋 一雄 (東北大金研)
	13:00～17:25	A棟-F (25)	フェムト秒レーザーを用いたマテリアルプロセスの新展開	中田 芳樹 (九大システム情報)
	13:00～17:25	8-V (25)	強誘電体薄膜の物性制御と次世代メモリデバイス	奥山 雅則 (阪大院基礎工) 野田 実 (阪大院基礎工)
	13:30～17:00	8-ZH (25)	多様化する理工系分野の人材開発と科学技術教育	喜岡 俊英 (東理大工)
	13:00～17:50	8-ZN (25)	九州地区における高分子材料の基礎及び応用研究の最前線	古川 昌司 (九工大情報工) 本岡 輝昭 (九大院工)
	14:00～17:55	10-YA (25)	プラズマのバイオ応用の新展開	井上 泰志 (名大)
9/1 (月)	12:30～18:35	A棟-D (25)	GaN電子デバイスの進展と実用化への課題	江川 孝志 (名工大) 吉川 俊英 (富士通研)
	13:30～17:30	A棟-F (26)	ランダム系有機、無機薄膜トランジスタの新展開	内藤 裕義 (大阪府大)
	14:00～18:15	8-ZH (26)	量子標準体系の高度化	細川 瑞彦 (通総研) 池上 健 (計量研)
	13:00～17:10	8-ZL (26)	ナノスピントロニクスのデザインと創製	朝日 一 (阪大産業科研)
	13:00～17:25	8-ZN (26)	超短パルスレーザーの時空間制御とその応用	須田 亮 (理研)
	13:00～17:15	10-YA (26)	次世代量産ウエーハの課題とその取り組み：アニール、エピ、およびSOIウエーハ	金田 寛 (富士通研) 小野 春彦 (ファインセラミックスセンタ)

注) 会場名の前は、号館を表示 (例：A棟-DはA棟のD会場、8-ZDは8号館のZD会場)。 ()内の数字はプログラム掲載頁。

■ 9. 超伝導 分科内総合講演

開催日	時 間	会 場	テ ー マ	世 話 人 (所 属)
9/1 (月)	9:00～12:00	A棟-D (58)	応用物理における超伝導研究の新展開	向田 昌志 (山形大)

注) 会場名の前は、号館を表示 (例：A棟-DはA棟のD会場)。 ()内の数字はプログラム掲載頁。

■ 応用物理学会論文賞 受賞記念講演

開催日	時 間	会場	題目ならびに受賞講演者
8/30 (土)	13:00～13:30	11-YL (69)	(解説論文賞) SOCを支える次世代半導体プロセス技術 産業技術総合研究所 ○廣瀬全孝
	13:30～13:50	10-YB (39)	(JJAP論文奨励賞) A Study of Distributed-Reflector Lasers Based on Deeply Etched Vertical Gratings Quantum Devices Inc. ¹ , Tokyo Institute of Technology ² , Fujitsu Quantum Devices Ltd. ³ , Archcom Technology Inc. ⁴ , Hanyang Univ. ⁵ ○Jörg Wiedmann ¹ , Hyo-Chang Kim ² , Koji Ebihara ³ , Bo Chen ⁴ , Masataka Ohta ² , Shigeo Tamura ² , Jong-In Shim ⁵ , Shigehisa Arai ²
8/31 (日)	13:00～13:30	A棟-G (84)	(JJAP論文賞) GaN系半導体レーザ特性の波長依存性 日亜化学工業 ○長浜慎一, 柳本友弥, 佐野雅彦, 向井孝志
	13:10～13:30	11-YL (66)	(JJAP論文奨励賞) フッ素化ポリイミドフィルム成形と光導波路への応用 三井化学 ○塩田剛史
	13:30～14:00	8-ZB (36)	(JJAP論文賞) 超短パルスファイバレーザと光ファイバにおける非線形効果を用いた超広帯域スーパーコンティニューム光の生成 名古屋大学 ○西澤典彦, 後藤俊夫
	14:00～14:20	10-YB (71)	(JJAP論文奨励賞) STPプロセスにおける材料粘性制御手法の提案と開発 NTT ○佐藤昇男, 町田克之, 矢野正樹, 工藤和久, 久良木健
	14:00～14:30	8-ZF (77)	(JJAP論文賞) 量子井戸構造のフォトンアシストトンネルとテラヘルツデバイス 東京工業大学 ○浅田雅洋
	14:00～14:30	10-YK (42)	(解説論文賞) 超高速フォトニクスの展開 大学評価・学位授与機構 ¹ , 東京大学 ² ○神谷武志 ¹ , 土屋昌弘 ²
9/1 (月)	11:00～11:20	A棟-F (89)	(JJAP論文奨励賞) アモルファス相からの微結晶シリコンの歪誘起核形成 産業技術総合研究所 ○藤原裕之, 近藤道雄, 松田彰久
	13:00～13:30	8-V (45)	(JJAP論文賞) Siを添加した強誘電体薄膜の諸特性 セイコーエプソン ¹ , 東京工業大学 ² ○木島健 ¹ , 石原宏 ²
	14:00～14:30	10-YD (74)	(JJAP論文賞) Si細線における電子正孔共存系を利用した単一電荷の検出 NTT ○藤原聡, 高橋庸夫

注) 会場名の前は、号館を表示 (例: 11-YLは11号館のYL会場, A棟-GはA棟のG会場), ()内の数字はプログラム掲載頁。

■ 第1回プラズマエレクトロニクス賞 受賞記念講演

開催日	時 間	会場	テ ー マ	受賞講演者 (所属)
8/31 (日)	13:30～14:00	10-YA (25)	コンパクト原子状ラジカル絶対密度計測装置の創製と反応性プラズマ中の水素、窒素ラジカルの挙動	高島 成剛 (日本レーザ電子)

注) 会場名の前は、号館を表示 (例: 10-YAは10号館のYA会場), ()内の数字はプログラム掲載頁。

■ 第3回光・量子エレクトロニクス業績賞 受賞記念講演

開催日	時 間	会場	テ ー マ	受賞講演者 (所属)
9/1 (月)	13:40～14:10	8-ZD (37)	非線形光学と超高速分光をめぐって	矢島 達夫 (日 大)

注) 会場名の前は、号館を表示 (例: 8-ZDは8号館のZD会場), ()内の数字はプログラム掲載頁。

■ 第1回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会論文賞 受賞記念講演

開催日	時 間	会場	テ ー マ	受賞講演者 (所属)
9/1 (月)	13:00～13:30	11-YL (67)	その場電界効果トランジスタ特性評価	工藤 一浩 (千 葉 大 工)
	13:30～14:00	11-YL (67)	有機ELの黎明期・現在・そして未来への展開	安達千波矢 (千歳科学技術大)

注) 会場名の前は、号館を表示 (例: 11-YLは11号館のYL会場), ()内の数字はプログラム掲載頁。